

SSY 20

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistor für den Einsatz als Schalttransistor in der Datenverarbeitungstechnik.

Bauform 1 TO39

Wärmewiderstand $R_{thja} \leq 0,22 \text{ K/mW}$
 $R_{thjc} \leq 0,04 \text{ K/mW}$

Grenzwerte gültig für den Betriebstemperaturbereich

U_{CBO}	60 V	I_B	100 mA
U_{CEO}	40 V	P_{tot} (bei $\vartheta_a \leq 25^\circ \text{C}$)	700 mW
U_{EBO}	5 V	ϑ_j	+175 °C
I_C	600 mA	ϑ_a	-40 °C bis +125 °C

Statische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ \text{C} - 5 \text{ K}$)

I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 50 \text{ V}$)	\leq	200 nA
I_{CBO}	(bei $U_{CB} = 60 \text{ V}$)		100 μA
$U_{(BR)EBO}$	(bei $I_E = 100 \mu\text{A}$)		5 V
$U_{(BR)CEO}$	(bei $I_C = 10 \text{ mA}$)		40 V
U_{CEsat}	(bei $I_C = 500 \text{ mA}$, $I_B = 50 \text{ mA}$)		1 V
U_{BEsat}	(bei $I_C = 500 \text{ mA}$, $I_B = 50 \text{ mA}$)		1,5 V
h_{21E}	(bei $I_C = 500 \text{ mA}$, $U_{CE} = 1,3 \text{ V}$)		Gruppe A 18...35 B 28...71

Dynamische Kennwerte ($\vartheta_a = 25^\circ \text{C} - 5 \text{ K}$)

t_{on}	(bei $I_C = 500 \text{ mA}$, $I_{B1} = 50 \text{ mA}$, $-I_{B2} = 25 \text{ mA}$, $R_L = 80 \text{ Ohm}$)	\leq 50 ns
t_{off}	(bei $I_C = 500 \text{ mA}$, $I_{B1} = 50 \text{ mA}$, $-I_{B2} = 25 \text{ mA}$, $R_L = 80 \text{ Ohm}$)	\leq 100 ns